

	<p>F.I.SH.: Xalilloev Mahkam Muhammadsharifovich</p> <p>LAVOZIM: O'qituvchi</p> <p>TEJ: +99893 741 48 66</p> <p>E – mail: <a href="mailto:x-mahkam@mail.ru">x-mahkam@mail.ru</a></p> <p>TASHKILOT TEL: +99862 2246700</p> <p>TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon ko'chasi 14. 220100</p>
<p><b>DARAJASI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 - 2012 Urganch davlat universiteti (bakalavr)</li> <li>• 2012 - 2014 yillarda O'zbekiston Milliy universiteti (magistr)</li> </ul>
<p><b>TAJRIBA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014-2015 - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida stajyor o'qituvchisi</li> <li>• 2015-2017 - Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida o'qituvchisi</li> <li>• 2018-2020 - Urganch davlat universiteti 01.04.10- Yarimo'tkazgichlar fizikasi ixtisosligi bo'yicha tayanch doktorant</li> <li>• 2021- Xozirgacha Urganch davlat universiteti fizika kafedrasida o'qituvchisi</li> </ul>
<p><b>MUTAXASSISLIGI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umumiy fizika (yo'nalishlar bo'yicha)</li> </ul>
<p><b>O'QITADIGAN FANLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umumiy fizika, Atom fizikasi, Radiofizika, Fizpraktikum</li> </ul>
<p><b>TADQIQOT ISHI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O'tishsiz nanoo'lchamli maydoniy tranzistorlarning xarakteristikalariga texnologik fluktuatsiyalarning ta'sirini modellashtirish</li> </ul>
<p><b>TADQIQOTLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A. E. Atamuratov, M.M Khalilloev, A. Abdikarimov, Z. A. Atamuratova, M. Kittler, R. Granzner, F. Schwierz Simulation of DIBL effect in junctionless SOI MOSFETs with extended gate//NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2017, 8 (1), P. 75–78 DOI 10.17586/222080542017817578</li> <li>• A Atamuratov, M.M Khalilloev, A Yusupov Simulation of DIBL effect and sub-threshold swing in low power junctionless MOSFETs with different geometries //International Journal of Applied Science – Research and Review, 2018, Volume: 5 DOI: 10.21767/2394-9988-C1-003</li> <li>• M.M Khalilloev, B. O. Jabbarova A. A. Nasirov The Influence of Fin Shape on the Amplitude of Random Telegraph Noise in the Subthreshold Regime of a Junctionless FinFET //Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 12, pp. 1245–1248.</li> <li>• A. E. Atamuratov, M.M Khalilloev, A. Yusupov, A. J. Garcia-Loureiro, Jean Chamberlain Chedjou, Kyamakya Kyandoghene Contribution to the Physical Modelling of Single Charged Defects Causing the Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET//Appl. Sci. 2020, 10, 5327; doi:10.3390/app10155327</li> <li>• Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Зависимость DIBL эффекта от формы канального слоя в безпереходном МОП- транзисторе//Яримўтказгичлар физикасининг ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг замонавий муаммолари мавзусида Республика илмий-амалий анжумани.- Андижон. 20-21 апрель, 2018. - б.91-93.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Халиллоев М.М., А.Э. Абдикаримов, З. Атамуратова, Б. Жаббарова, А.Э. Атамуратов. Короткоканальные эффекты в безпереходном МОП-транзисторе с различным уровнем легирования и формой базы//Республиканской научно-практической конференции участием зарубежных ученых «Инновационные технологии в науке и образовании». - Нукус. 20-21 ноября, 2018. - С. 106-107.</li> <li>• Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя в безпереходном МОП-транзисторе на крутизну подпороговой переходной характеристики Мухаммад ал-Хоразмий издошлари мавзусидаги Республика илмий-техникавий анжумани - Урганч. 27-28 апрель, 2018. - б.68-69</li> <li>• Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Зависимость крутизны передаточной характеристики от боковых линейных размеров затвора и скрытого оксидного слоя в безпереходном МОП-транзисторе Физика фанининг ривожиди истеъдодли ёшларнинг ўрни РИАК-ХИ-2018 – Тошкент. 11-12 май, 2018 - б.25-26</li> <li>• Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя и бокового расширения затвора на пороговое напряжение в безпереходном МОП-транзисторе //Материалы международной конференции «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах». - Фергана. 25-26 мая, 2018.- С. 295-296</li> <li>• Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Сравнение амплитуды случайных телеграфных шумов в МОП транзисторах без переходов и с инверсионным каналом//«Современные проблемы физики полупроводников» СПФП-2019 –Нукус 20 ноября 2019 г. 82-86</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>HOZIRGI TADQIQOTLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atabek E. Atamuratov, Mahkam M. Khalilloev, Ahmed Yusupov, Jean Chamberlain Chedjou, Kyandoghene Kyamakya Amplitude of Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET with Different Channel Shape// e-Journal of Surface Science and Nanotechnology <b>19</b>, 9–12 (2021)</li> <li>• A.E.Atamuratov, B.O. Jabbarova, M.M. Khalilloev, A. Yusupov, A.G.J.Loureiro Self-heating effect in nanoscale SOI Junctionless FinFET with different geometries// 13th Spanish Conference on Electron Devices</li> <li>• Atabek E. Atamuratov, Mahkam M. Khalilloev, Ahmed Yusupov, A. J. Garcia-Loureiro, Jean Chamberlain Chedjou and Kyamakya Kyandoghene Contribution to the Physical Modelling of Single Charged Defects Causing the Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET// <i>Appl. Sci.</i> 2020, <i>10</i>, 5327; doi:10.3390/app10155327.</li> </ul>